

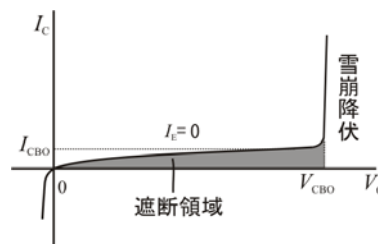
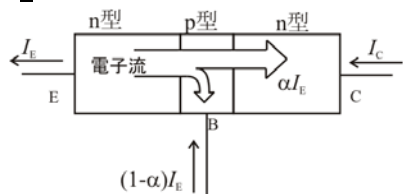
7-1-1 ベース接地トランジスタの出力特性

 $I_E = 0$ のとき

ベース-エミッタ間が開放していると考える。

このとき、コレクタ接合には pn 接合の逆バイアス時の飽和電流が流れる。この電流を「コレクタ遮断電流 I_{CBO} 」という。

Fig.1 の塗りつぶしの領域を「遮断領域 (cut-off region)」という。

Fig.1 $I_E = 0$ の時の静特性 $I_E > 0$ のときFig.2 $I_E > 0$ の時の電子流

α : 電流増幅率 (current amplification factor) または電流伝達率

$$\alpha = \frac{I_C - I_{CBO}}{I_E}$$

I_{CBO} は通常非常に小さいため、

$$\alpha \cong \frac{I_C}{I_E}$$

通常、 α は 1 に近い値になるので、 I_C と I_E はほぼ同じ値となる。

I_C が V_C に依存せず、一定の値となる領域を「活性領域 (active region)」という(完全に一定というわけではなく、 V_C 増大で僅かに I_C も増加する)。

「突き抜け(punch through)」現象: ベースの抵抗率が高いと V_C を増加した場合、コレクタ接合の空乏層がベース側に広がっていき、エミッタ接合とつながってトランジスタ作用が失われる。

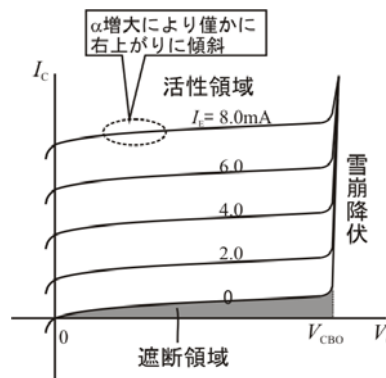
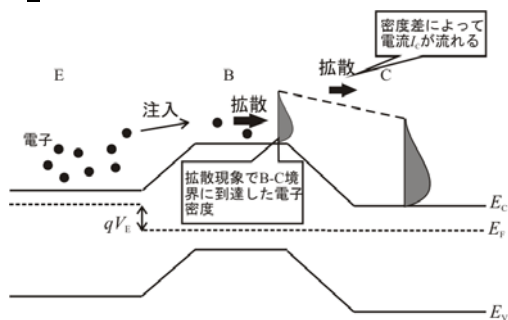
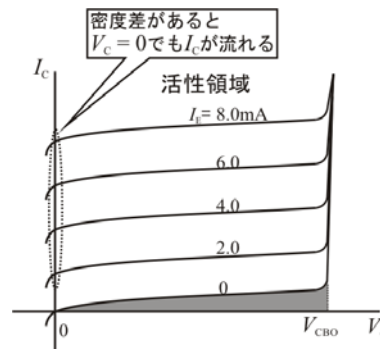


Fig.3 活性領域

 $V_C = 0$ のときFig.4 $V_C = 0$ の時のバンド図

1. エミッタ接合: 順バイアス印加
エミッタからベースに少数キャリア注入
2. ベース領域を拡散現象で移動してコレクタ接合に達する。
3. コレクタ接合のベース側とコレクタ側のキャリア密度差によってキャリアが移動、すなわち電流 I_C が流れる。

Fig.5 密度差による I_C 電流

$V_C < 0$ のとき

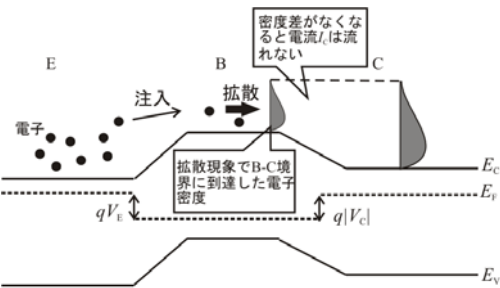


Fig.6 $V_C < 0$ の時のバンド図

- 1. コレクタ接合: 順バイアス印加
- 2. コレクタ接合のベース側とコレクタ側のキャリアの密度差がなくなると電流 I_C が流れなくなる。

$I_C = 0$

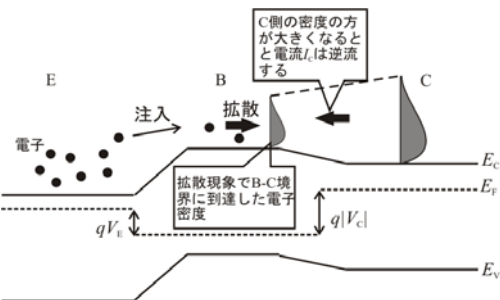


Fig.7 コレクタ電流の逆流

この領域を「飽和領域 (saturation region)」という。

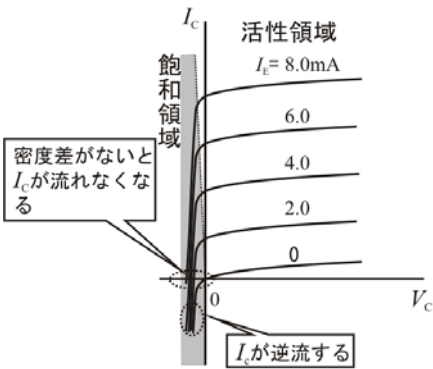


Fig.8 飽和領域

以上をまとめると、ベース接地の出力特性は Fig.9 に示すようになる。また、各領域の印加バイアスの状態を Table1 に示す。

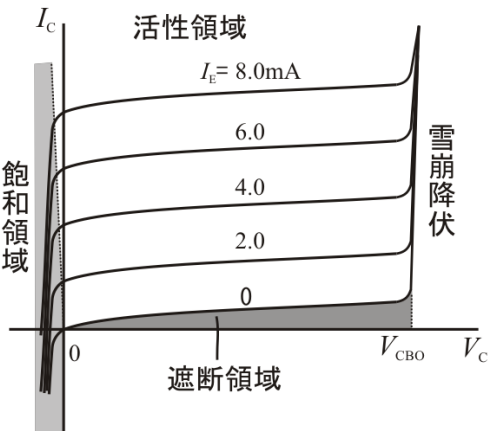


Fig.9 ベース接地トランジスタの出力特性

Table1. 各領域のバイアス状態

	エミッタ接合	コレクタ接合
活性領域	順バイアス	逆バイアス
飽和領域	順バイアス	順バイアス
遮断領域	逆バイアス	順バイアス